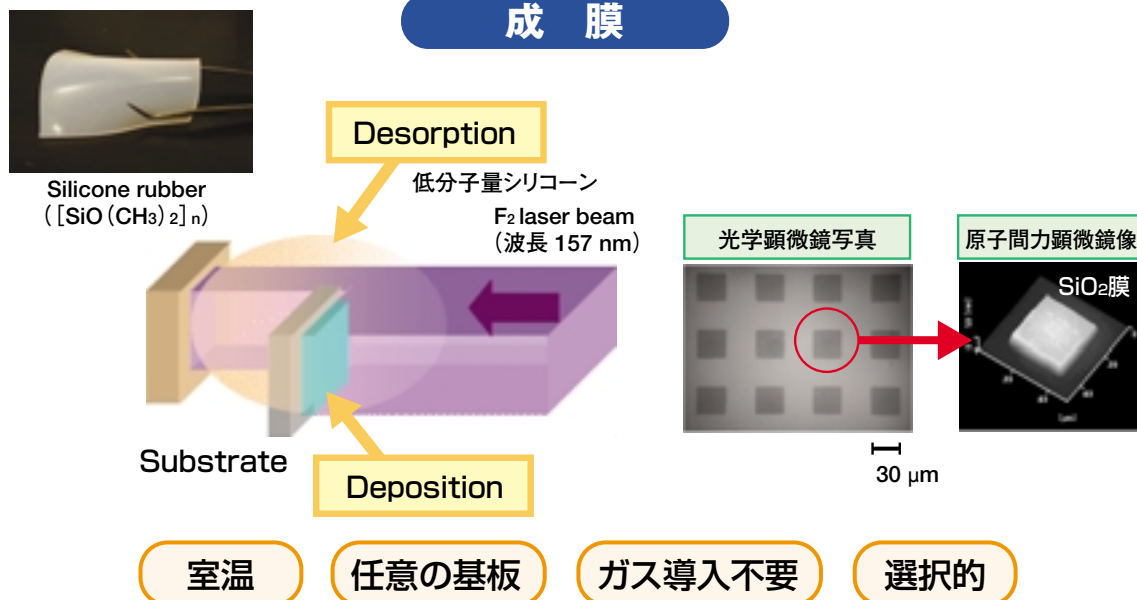


真空紫外レーザーによるSiO₂膜の室温形成

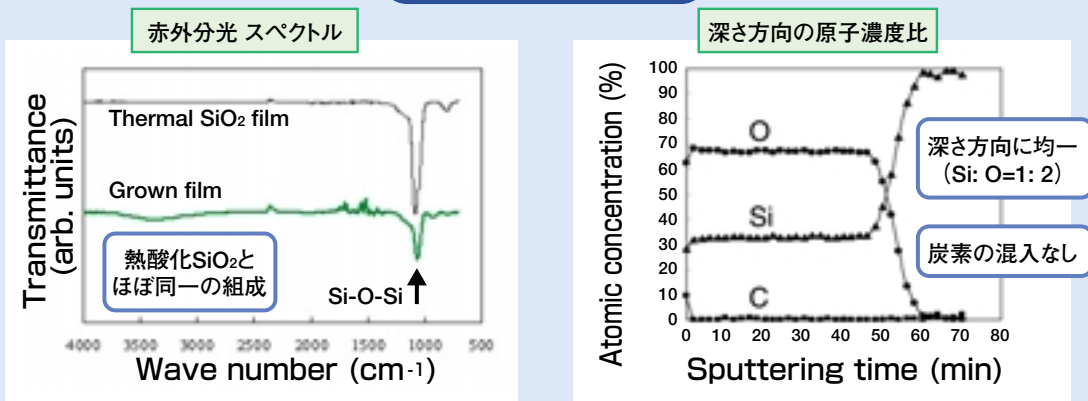
防衛大 電気電子 高尾寛弘, 深見裕子, 大越昌幸, 井上成美

シリコンゴムと基板へ同時にF₂レーザー光を照射することにより、任意の基板の上にSiO₂膜を室温形成させる手法を見出した。

成膜



組成



原料ガスの供給及び排気処理を必要とせず、容易に任意の基板の上にSiO₂膜を形成でき、電子・光学デバイス等への応用が期待される。

連絡先 〒239-8686 神奈川県 横須賀市 走水1-10-20 防衛大学校 電気情報学群 電気電子工学科 井上成美 (E-mail : narumi@nda.ac.jp)